

2 ТРАНЗИСТОРЫ

2.1 Полевые n-канальные транзисторы ($T_k = 25^\circ\text{C}$)

Тип	Аналог	$U_{\text{смах, В}}$	$I_{\text{смах, А}}$	$R_{\text{сиотк., Ом}}$	$P_{\text{мах, Вт}}$	Корпус	ТУ	
Транзисторы в металлопластмассовых корпусах								
2П769А	IRF520	100	8,5	0,27	50	КТ-28-2	АЯЕР.432140.220ТУ	
2П769Г ¹	-	100	8,5	0,27	50			
2П769В	IRF540	100	25	0,077	100			
2П769Д	-	100	25	0,052	100			
2П769Е ²	-	100	30	0,039	100			
2П767А	IRF620	200	5	0,8	50			
2П767Ж	-	200	16	0,12	100			
2П767В	IRF640	200	16	0,18	100			
2П767Е ¹	-	200	16	0,18	100			
2П768А	IRF720	400	3	1,8	55			
2П768К	IRF740	400	9	0,55	125			
2П768П	-	400	9	0,42	125			
2П769А9	IRFR120	100	7	0,27	42	КТ-89		
2П767А9	IRFR220	200	4,5	0,8	42			
2П768А9	IRFR320	400	2,8	1,8	42			
2П769В91	IRF540S	100	25	0,077	100	КТ-90		
2П769Д91	-	100	25	0,052	100			
2П769Е91 ²	-	100	30	0,039	100			
2П767В91	IRF640S	200	16	0,18	100			
2П767Ж91	-	200	16	0,12	100			
2П768К91	IRF740S	400	9	0,55	125			
2П768П91	-	400	9	0,42	125	КТ-43В		
2П790А	IRFP150	100	35	0,055	150			
2П790Б	-	100	35	0,030	150			
2П793А	IRFP250	200	27	0,085	155			
Транзисторы в металлокерамических корпусах								
2П767В3	-	200	16	0,18	100	КТ-56		АЯЕР.432140.273ТУ
2П707Б	-	600	3,6	2	100			АЯЕР.432140.160ТУ
2П769В92	IRFN140	100	25	0,077	100	КТ-94-1		АЯЕР.432140.273ТУ
2П769Д92	-	100	25	0,052	100			
2П790А92	IRF150	100	35	0,055	150			
2П790Б92	-	100	35	0,030	150			
2П767В92	IRFN240	200	16	0,18	100			
2П767Ж92	-	200	16	0,12	100			

¹ $U_{\text{ЗИпор.}} = (1,5 \div 2,7) \text{ В}$; ² $2,0 \text{ В} \leq U_{\text{ЗИпор.}} \leq 4,0 \text{ В}$; для остальных $U_{\text{ЗИпор.}} = (1,5 \div 6,0) \text{ В}$



КТ-28-2



КТ-89



КТ-90



КТ-43В



КТ-56



КТ-94-1

2 ТРАНЗИСТОРЫ

2.1 Полевые n-канальные транзисторы ($T_k = 25 \text{ }^\circ\text{C}$)

Тип	Аналог	$U_{\text{смах, В}}$	$I_{\text{смах, А}}$	$R_{\text{сиотк., Ом}}$	$P_{\text{мах, Вт}}$	Корпус	ТУ	
Транзисторы в металлокерамических корпусах								
2П793А92	IRF250	200	27	0,085	150	КТ - 94-1	АЯЕР.432140.273ТУ	
2П768П92	—	400	9	0,42	125			
2П794А92	IRF350	400	15	0,3	150			
2П794В92	—	400	15	0,2	150			
2П770К92	IRF440	500	8	0,85	100			
2П770П92	—	500	8	0,55	100			
2П795А92	IRFN450	500	14	0,4	150	КТ-28А-2.02		
2П782Ж2	IRFM054	60	16	0,04	100			
2П769В2	IRFY140С	100	14	0,077	75			
2П769Д2	—		25	0,052	75			
2П767В2	IRFY240С	200	16	0,18	100			
2П767Ж2	—			0,12	100			
2П770К2	IRFY440С	500	8	0,85	100			
2П770П2	—			0,55	100			
2П707В2	IRFPE30	800	4,1	3	125			
2П790А4	IRFM150	100	30	0,055	120			КТ-43А-1.01
2П790Б4	—			0,03	120			
2П793А4	IRFM250	200	25	0,085	130			
2П795А4	IRFM450	500	14	0,4	150			
Транзисторы в металлостеклянных корпусах								
2П782Ж1	IRF044	60	45	0,028	125	КТ - 9С		АЯЕР.432140.273ТУ
2П769В1	IRF140	100	25	0,077	100			
2П769Д1	—			0,052	100			
2П790А1	IRF150			35	0,055			
2П790Б1	—	0,03	150					
2П767В1	IRF240	200	16	0,18	100			
2П767Ж1	—			0,12	100			
2П793Б1	IRF240		20	0,12	125			
2П793А1	IRF250			0,085	150			
2П794Б1	IRF350	400	10	0,3	100			
2П794А1				15	0,3		150	
2П794В1					0,20		150	
2П770К1	IRF440	500	8	0,85	100			
2П770П1	—			0,55	100			
2П795Б1	IRF440		10	0,6	125			
2П795А1	IRF450			14	0,4		150	



КТ-94-1



КТ-28А-2.02



КТ-43А-1.01



КТ - 9С

2 ТРАНЗИСТОРЫ

2.2 Полевые р-канальные транзисторы

Тип	Аналог	$U_{\text{симах, В}}$	$I_{\text{смах, А}}^1$	$R_{\text{сиотк., Ом}}$	$P_{\text{мах, Вт}}^1$	Корпус	ТУ
2П7229В2	IRF9640	-200	-15	0,29 ³	100	КТ-28А-2.02	АЯЕР.432140.558ТУ
2П7229А2	IRF5М5210	-100	-30	0,065 ²	100		
2П7229Б2				0,07 ²			
2П7229А	IRF5210	-100	-40	0,055 ²	150	КТ-28-2	
2П7229Б				0,060 ²			
2П7229В	IRF9640	-200	-16	0,27 ³	130	КТ-90	
2П7229В91	IRF9640						

¹ $T_k = 25 \text{ }^\circ\text{C}$; ² $U_{\text{зи}} = -10\text{В}$, $I_c = -24\text{А}$; ³ $U_{\text{зи}} = -10\text{В}$, $I_c = -9\text{А}$

2.3 Транзисторные сборки с n- и р- каналами ($T_k=25 \text{ }^\circ\text{C}$)

Тип	$U_{\text{симах, В}}$	$I_{\text{смах, А}}$	$R_{\text{сиотк., Ом}}$	$P_{\text{мах, Вт}}$	Корпус	ТУ
2П7241ГС9 ²	-20	-4,7	0,030	2	4320.8-А	АЯЕР.432140.605ТУ
2П7241АС9 ²	-30	-8	0,035			
2П7241БС9 ²	-60	-3,5	0,250			
2П7241ВС9 ²	-100	-1,5	0,500			
2П7240ГС9 ¹	20	8,7	0,022			
2П7240АС9 ¹	30	10	0,020			
2П7240БС9 ¹	60	5	0,060			
2П7240ВС9 ¹	100	3,5	0,085			
2ПЕ102АС9 ⁴	-100	-1,5	0,48		МК 5205.8-1	АЯЕР.432140.686ТУ
2ПЕ101АС9 ³	100	2,1	0,21			

¹ $U_{\text{пор}} = (1,5 \div 2,5)\text{В}$; ² $U_{\text{пор}} = (|-1,0| \div |-2,5|)\text{В}$; ³ $U_{\text{пор}} = (1,5 \div 6,0)\text{В}$; ⁴ $U_{\text{пор}} = (|-2,5| \div |-5,0|)\text{В}$.

2.4 Комплементарные пары транзисторов с n- и р- каналами ($T_k=25 \text{ }^\circ\text{C}$)

Тип	$U_{\text{симах, В}}$	$I_{\text{смах, А}}$	$R_{\text{сиотк., Ом}}$	$P_{\text{мах, Вт}}$	Корпус	ТУ
2П7247ГР9 ¹	20	8,7	0,022	2	4320.8-А	АЯЕР.432140.605ТУ
	-20	4,7	0,030			
2П7247АР9 ¹	30	10	0,020			
	-30	-8	0,035			
2П7247БР9 ¹	60	5	0,060			
	-60	-3,5	0,250			
2П7247ВР9 ¹	100	3,5	0,085			
	-100	-1,5	0,500			

¹ для n- канала: $U_{\text{пор}} = (1,5 \div 2,5)\text{В}$; для р- канала: $U_{\text{пор}} = (|-1,0| \div |-2,5|)\text{В}$



КТ-28А-2.02



КТ-28-2



КТ-90



4320.8-А



МК 5205.8-1

2 ТРАНЗИСТОРЫ

2.4 Комплементарные пары транзисторов с n- и p- каналами ($T_k=25^\circ\text{C}$)

Тип	$U_{\text{ситах, В}}$	$I_{\text{смах, А}}$	$R_{\text{сиотк., Ом}}$	$P_{\text{мах, Вт}}$	Корпус	ТУ
2ПЕ103АС ²	100 -100	2,5 -1,5	0,21 0,48	2	МК 5205.8-1	АЕЯР.432140.686ТУ

² для n- канала: $U_{\text{пор}} = (1,5 \div 6,0)\text{В}$; для p- канала: $U_{\text{пор}} = (|-2,5| \div |-5,0|)\text{В}$

2.5 Биполярные транзисторы с изолированным затвором ($T_k=25^\circ\text{C}$)

Тип	Аналог	$U_{\text{кзтах, В}}$	$I_{\text{кзтах, А}}$	$U_{\text{кз откр, В}}$	$P_{\text{мах, Вт}}$	Корпус	ТУ
2Е901А	IRG4PH50UD	1200	35	4	150	КТ-43А-1.01	АЕЯР.432140.640ТУ
2Е901Б	IXGH16N170	1700	20	5	100	КТ-109А-1К (Изолированное основание)	
2Е901В	IXLF19N250А	2500	15	6	100		

2.6 Биполярные транзисторы

Тип	Аналог	Технология	$P_{\text{кмах, Вт}}$	$U_{\text{кзтах, В}}$	$I_{\text{кзтах, А}}$	$h_{21Э}$	$U_{\text{кз нас, В}}$ не более, В	$I_{\text{кбо, В}}$ не более, В	$F_{\text{гр, МГц}}$	$t_{\text{рас, нс}}$ не более, нс	Корпус	ТУ
2Т301Г	-	n-p-n	0,15	30	0,06	10-32	3,0	0,005	60	-	КТЮ-3-1	ЩБ3.365.007ТУ
2Т301Д	2N1390					20-60						
2Т301Е						40-120						
2Т301Ж						80-300						
2Т312А			0,225	30	12-100	0,5	0,001	80	100	ЖК3.3 65.143ТУ		
2Т312А ОС					25-100			130				
2Т312Б			50-250	0,35	45-100	-	-	120	130	ЖК3.365.143ТУ/Д6 аА0.339.190 ТУ		
2Т12Б ОС					130			ЖК3.365.143ТУ/Д3				
2Т312Б1 ¹					130			ЖК3.365.143ТУ				
2Т312Б1 ОС ¹					130			ЖК3.365.143ТУ/Д6 аА0.339.190 ТУ				
2Т312В					130			ЖК3.365.143ТУ				
2Т312В ОС					130			ЖК3.365.143ТУ/Д6 аА0.339.190 ТУ				
2Т312В1 ¹					130			ЖК3.365.143ТУ/Д3				
2Т312В1 ОС ¹					130			ЖК3.365.143ТУ/Д3 аА0.339.190 ТУ				
2Т312Д ²			0,06	12	0,008	20-100	-	0,001	-	-		ЖК3.365.143ТУ/Д2

¹ Радиационно-стойкие; ² $K_{\text{ш}} \leq 5 \text{ дБ}$ (при $U_{\text{кб}} = 3 \text{ В}$; $I_{\text{э}} = 150 \text{ мкА}$; $f = 1000 \text{ Гц}$; $R_{\text{ГЕН}} = 600 \text{ Ом}$)



МК5205.8-1



КТ- 43А-1.01



КТ-109А-1К



КТЮ-3-1

2 ТРАНЗИСТОРЫ

2.6 Биполярные транзисторы

Тип	Аналог	Технология	$P_{к\max}, \text{Вт}$	$U_{к\max}, \text{В}$	$I_{к\max}, \text{А}$	$h_{21э}$	$U_{кз\text{ нас.}}$ не более, В	$I_{к\text{БО}}$ не более, В	$F_{гр}, \text{МГц}$	$t_{рас.}$ не более, нс	Корпус	ТУ	
П307	-	n-p-n	0,25	80	0,03	20-60	-	0,003	10	-	КТЮ-3-6	ЖК3.365.059ТУ	
П307В	-			50-150									
П308	-			30-90									
П309	-			20-60									
2Т602А	-		2,8	120	0,15	20-180	3,0	0,01	100	-	КТЮ-3-9		
2Т602Б	-					50-200							
2Т903А	2SC517	30	60	3	15-70	2,0	2	120	-	КТЮ-3-20	И93.365.004ТУ		
2Т903Б	2N2947				40-180								
2Т837А		p-n-p	30	80	8	>15	0,9	0,15	-	1000	КТ-28-2	аА0.339.411ТУ	
2Т837Б				60		>30							
2Т837В				45		>40							
2Т837Г				80		>15							
2Т837Д				60		>30							
2Т837Е				45		>40							
Транзисторные матрицы													
1НТ251	2N3903	4 n-p-n	0,4	45	0,4	30-150	1,0	0,006	-	120	401.14-6	И93.456.000ТУ	
1НТ251 ОС												И93.456.000ТУ /Д6 аА0.339.190 ТУ	
1НТ251А	-											200	И93.456.000ТУ
1НТ251А ОС													И93.456.000ТУ /Д6 аА0.339.190 ТУ
2ТC622А	2N3905	4 p-n-p	0,4	45	0,4	25-150	1,3	0,01	-	120	401.14-6	И93.456.001ТУ	
2ТC622А ОС												И93.456.001ТУ /Д6 аА0.339.190 ТУ	
2ТC622Б	-											200	И93.456.001ТУ
2ТC622Б ОС													И93.456.001ТУ /Д6 аА0.339.190 ТУ
Радиационно-стойкие транзисторные сборки													
1НТ251А2	-	4 n-p-n	0,4	45	0,4	80-350	1,0	0,015	-	200	401.14-6	И93.456.00ТУ/Д1	
1НТ251А2 ОС	-					И93.456.00ТУ/Д1 аА0.339.190 ТУ							
2ТC622А1	2N3905	4 p-n-p				70-350	1,3	0,03				И93.456.00ТУ/Д1	
2ТC622А1 ОС												И93.456.00ТУ/Д1 аА0.339.190 ТУ	



КТЮ-3-6



КТЮ-3-9



КТЮ-3-20



КТ-28-2



401.14-6

2 ТРАНЗИСТОРЫ

2.6 Биполярные транзисторы

Тип	Аналог	Технология	$P_{к\text{тлах}}$, Вт	$U_{к\text{эмах}}$, В	$I_{к\text{тлах}}$, А	$h_{21Э}$	$U_{к\text{э нас.}}$ не более, В	$I_{к\text{Б0}}$ не более, В	$F_{гр}$, МГц	$t_{рас}$, нс не более, нс	Корпус	ТУ
2Т689АС	2N3799	4 п-р-п	0,4	45	0,3	50-150	1,0	0,007	-	-	401.14-6	аА0.339.758ТУ
2Т689АС ОСМ												аА0.339.758ТУ ПО.070.052
2Т690АС	2N4123	4 р-р-р			0,3	50-150	0,8	0,005		165		аА0.339.759ТУ
2Т690АС ОСМ										-		аА0.339.758ТУ ПО.070.052

2.7 ВЧ и СВЧ мощные транзисторы

2.7.1 Транзисторы для стационарной и бортовой аппаратуры радиосвязи

Тип	Аналог	f , МГц	$P_{в\text{ых}}$, Вт	$U_{к\text{э}}$, В	$K_{ур}$, раз	η , %	Корпус	ТУ	
2Т922А	2N5641	175	5	28	10,0	55	КТ-17	И93.365.027ТУ	
2Т922Б	2N5642		20		5,5				
2Т922В	2N5643		40		4,0				
2Т931А	2N6369	50÷200	80		4,0	50	КТ-32	аА0.339.037ТУ	
2Т907А	2N3733	100÷400	8		2,0	40	КТ-4	И93.365.015ТУ	
2Т934А	2N5635		3		6,0				
2Т934Б	2N5636		12		3,0				
2Т934В	2N5637		25		3,0				
2Т930А	2N6362		40		5,0				
2Т930Б	2N6364		75		4,0				
2Т970А	-		100		4,0				
2Т985АС	-	220÷400	125		3,5	50	КТ-45	аА0.339.408ТУ	
2Т9105АС	-	500	100		4,0	50	КТ-45	аА0.339.529ТУ	
2Т9125АС	-		50	8,0					
2Т991АС	-	400÷1800	55	3,5	30	КТ-44	аА0.339.437ТУ		
2Т9101АС	-		100	40					
2Т911А	-		0,8	2,0					
2Т911Б	-	400÷1000	10	28	4,0	36	КТ-17	аА0.339.168ТУ	
2Т962А	DM10-28				20	3,5			40
2Т962Б	DM20-28				40	3,0			40
2Т962В	DM40-28				40	3,0			40
2Т9132АС	-	650	140	30	3,5	55	КТ-44	аА0.339.722ТУ	



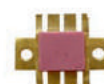
401.14-6



KT-56



KT-4



KT-45



KT-17



KT-32



KT-44



KT-18

2 ТРАНЗИСТОРЫ

2.8 Полевые n-канальные транзисторы ($T_k=25\text{ }^\circ\text{C}$) (приёмка «ОТК»)

Тип	Аналог	$U_{\text{Смах, В}}$	$I_{\text{Смах, А}}$	$R_{\text{СИотк., Ом}}$	$P_{\text{мах, Вт}}$	Корпус	ТУ
КП707А1	-	400	15 ¹	1	50	КТ-28-2	АДБК.432140.140ТУ
КП707Б1		600	10 ¹	2	50		АДБК.432140.140ТУ
КП707В2	-	650-800	6-9(1)	2,3-3	50		АДБК.432140.140ТУ/Д1
КП707В1	-	800	7(1)	3	50		АДБК.432140.140ТУ
КП767А9	-	200	4,5	0,8	42	КТ-89	АДБК.432140.740ТУ
КП768А9	-	400	2,8	1,8	42		АДБК.432140.743ТУ
КП769А9	-	100	7	0,27	42		АДБК.432140.744ТУ
КП769В	IRF540	100	28	0,077	150	КТ-28-2	
КП790А	-	100	41	0,055	230	КТ-43В	АДБК.432140.906ТУ
КП813А2	-	200	22	0,12	125		АДБК.432140.441ТУ
КП793А	-	200	30	0,085	190		АДБК.432140.927ТУ
КП809Б2	-	500	20	0,6	100		АДБК.432140.331ТУ
КП809А	-	400	25	0,3	100	КТ-9С	АДБК.432140.331ТУ
КП809Б	-	500	20	0,6	100		

¹ Импульсный ток стока



КТ-28-2



КТ- 89



КТ-90



КТ- 43В



КТ-9С

2 ТРАНЗИСТОРЫ
БЕСКОРПУСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
2.9 Полевые n-канальные транзисторы

 Параметры при $T_{\text{окр.ср.}} = 25^{\circ}\text{C}$

Тип	$U_{\text{си, В}}$	$R_{\text{сиотк., Ом}}$	ТУ
2П790Б-5	100	0,03	АЕЯР.432140.220ТУ
2П769Е-5 ²	100	0,039	
2П769Д-5	100	0,052	
2П790А-5	100	0,055	
2П769В-5	100	0,077	
2П769А-5	100	0,27	
2П769Г-5 ¹	100	0,27	
2П793А-5	200	0,085	
2П767Е-5 ¹	200	0,18	
2П767А-5	200	0,8	
2П768К-5	400	0,55	
2П768 А-5	400	1,8	
2П707Б-5	600	2,0	
2П707В-5	800	3,0	
2П782Ж2-5	60	0,028	АЕЯР.432140.273ТУ
2П767Ж-5	200	0,12	
2П767В-5	200	0,18	
2П794В-5	400	0,2	
2П794А-5	400	0,3	
2П768П-5	400	0,42	
2П795А4-5	500	0,4	
2П770П-5	500	0,55	
2П795Б-5	500	0,6	
2П770К2-5	500	0,85	

¹ $U_{\text{пор}} = (1,5 \div 2,7)$ В; для остальных $U_{\text{пор}} = (1,5 \div 6,0)$ В; ² $2,0 \leq U_{\text{зипор}} \leq 4,0$ В